НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе

Драгунов В.К.

« 16» Utous

2015 г.

Программа аспирантуры

Направление 22.06.01 Технологии материалов

Направленность (специальность) 05.16.09 Материаловедение (по отраслям)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины по выбору

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ»

Индекс дисциплины по учебному плану: Б1.В.ДВ.4.1

Всего: 108 часов

Семестр 7, в том числе

6 часов - консультация,

84 часа — самостоятельная работа,

18 часов - контроль

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки <u>22.06.01 Технологии материалов</u>, утвержденного приказом Минобрнауки России от <u>30 июля 2014 г.</u> № 888, и паспорта специальности, указанной в номенклатуре специальностей научных работников <u>05.16.09 Материаловедение (по отраслям)</u>, утвержденной приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основных методов исследования структуры, фазового и химического состава материалов, применяемых в материаловедении.

Задачами дисциплины являются:

- изучение основных методов исследования материалов с использованием оптической и электронной микроскопии, а так же рентгеновской, оптико-эмиссионной и масс- спектрометрии;
 - изучение физических основ работы исследовательского оборудования.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- способность и готовность обрабатывать результаты научноисследовательской работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады (ОПК-4);
- способность выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения экспериментов и регистрации их результатов (ОПК-10);
- способность использовать современные методы подготовки и исследования образцов для оптической, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии (ПК-22);
- способность использовать фундаментальные знания в области оптики и квантовой физике и физике твердого тела для грамотного описания и интерпретации результатов экспериментов и наблюдений (ПК-23).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- методы обработки экспериментальных данных (ОПК-4);
- основные методы подготовки образцов для различных методов исследования (ОПК-10);

- устройство оптических микроскопов, основы оптики (раздела физики), виды аберраций и методы борьбы с ними, а также и условия получения контраста в оптических микроскопах (ПК-23);
- устройство просвечивающих и растровых электронных микроскопов, физику взаимодействия электронных пучков с материалами и условия получения контраста на изображениях (ПК-23);
- основные методы определения химического состава материалов и особенности каждого метода (ПК-23);
- особенности дифракции электронных и рентгеновских пучков на кристаллической решетке материалов (ПК-23).

Уметь:

- подготавливать образцы для исследований и выбирать необходимое оборудование и методики для различных исследований (ПК-22);
- описывать и расшифровывать данные полученные с оптических и электронных микроскопов (ПК-23);

Владеть:

- навыками описания и обработки результатов экспериментов, микро- и наноструктуры материалов (ОПК-4);
 - навыками работы с металлографским оборудованием (ПК-22)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Математические методы обработки экспериментальных данных

Основные положения теории вероятностей. Эксперимент как предмет исследования. Ошибки измерений и их оценка. Ошибки измерений: промахи, систематические, случайные. Обработка результатов прямого измерения. Округление результатов. Выборочный метод. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Функция распределения. Плотность распределения вероятностей. Законы распределения вероятностей: нормальный, показательный, равномерный. Количественная металлография.

Методы пробоподготовки образцов для металлографических исследований Задачи металлографического исследования и испытания материалов. Условия получения изображений в оптической микроскопии. Способы обработки поверхности образца. Технология изготовления образцов. Изготовление специальных образцов. Способы металлографического травления. Приготовление объектов для ПЭМ. Метод реплик и его применение.

Оптическая микроскопия

Оптическая схема инвертированного микроскопа отраженного света. Основные узлы микроскопа. Типы микроскопов. Разрешающая способность, числовая апертура и глубина резкости микроскопа. Полезное увеличение. Аберрации оптических систем. Типы объективов по степени исправления аберраций. Методы контрастирования. Преимущества и недостатки использования оптической микроскопии в материаловедении.

Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия

Принцип работы просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). Формирование изображения в ПЭМ. Основные типы контраста в ПЭМ. Основы кинематической теории дифракционного контраста. Принципы динамической теории. Контраст на кристаллах с дефектами. Анализ гетерогенного сплава. Контраст собственно на включениях. Режим СТЭМ. Принцип работы сканирующего (растрового) электронного микроскопа (РЭМ). Основные типы сигналов, которые генерируются и детектируются в процессе работы РЭМ. Разрешающая способность. Преимущества и недостатки использования электронной микроскопии в материаловедении.

Методы определения химического состава материалов

Пробирный метод. Рентгенофлуоресцентный анализ. Эмиссионные методы. Основные спектрометров определения ТИПЫ ДЛЯ состава металлов: рентгенофлуоресцентный спектрометр, искровой оптико-эмиссионный спектрометр, лазерный спектрометр, масс-спектрометр. Преимущества и Взаимодействие недостатки. электронного пучка образцом. Рентгеноспектральный микроанализ в электронной микроскопии.

Методы определения фазового состава материалов

Основные методы определения фазового состава. Качественный и количественный рентгенографический фазовый анализ. Дифракция электронов в ПЭМ. Дифракция отраженных электронов в РЭМ.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: 4 семестр – дифференцированный зачет.

Вопросы для самоконтроля и проведения зачета

а) Вопросы для самоконтроля

- 1. Каковы причины возникновения ошибок измерений при эксперименте?
- 2. От чего зависит погрешность результатов? Как можно ее оценить и минимизировать?
- 3. Какие законы распределения вероятностей вы знаете? Что такое плотность распределения вероятностей?
- 4. Какие способы определения размера зерна вы знаете? В чем преимущества и недостатки каждого?
- 5. Почему металлографические образцы шлифуются и полируются в несколько шагов?
- 6. Зачем нужно травление образцов?
- 7. Какие способы травления вы знаете?
- 8. Почему возникает контраст на поверхности образца?
- 9. Как можно подготовить образец для ПЭМ?
- 10. В чем преимущества и недостатки метода реплик?
- 11. Как избавиться от наклепанного слоя при подготовке образцов для РЭМ?

- 12. Что такое инвертированный микроскоп?
- 13. Какие виды осветителей бывает у оптических микроскопов? Какие у них есть преимущества и недостатки?
- 14. Зачем нужна апертурная диафрагма?
- 15. Бывают ли точечные осветители?
- 16. Какие виды аберраций оптических систем вы знаете?
- 17. Почему возникают сферические аберрации?
- 18. Почему возникают хроматические аберрации, как с ними бороться??
- 19. Что такое дисторсия?
- 20. Что такое числовая апертура?
- 21. Зачем применяют иммерсионное масло?
- 22. Что значит, если на объективе написано «plan achromat»?
- 23. Какие методы контрастирования в оптической микроскопии вы знаете?
- 24. Чем ограничена разрешающая способность оптической системы?
- 25. Почему разрешающая способность электронных микроскопов на несколько порядков выше оптических?
- 26. Как формируется изображение в ПЭМ?
- 27. Какие виды катодов бывают в электронных микроскопах?
- 28. Как можно добиться контраста в ПЭМ?
- 29. От чего зависит глубина проникновения электрона в материал?
- 30. Какие виды излучения генерируются при взаимодействии электронных пучков с образцом? Для чего их можно использовать?
- 31. Что такое гониометр?
- 32. Какие преимущества и недостатки у РЭМ по сравнению с ПЭМ?
- 33. Какие методы определения химического состава вы знаете?
- 34. В чем преимущества и недостатки пробирного метода?
- 35. Какие области применения у различных спектрометров?
- 36. Какие спектрометры применяются в электронной микроскопии в качестве дополнительной приставки?
- 37. На чем основан принцип определения фазового состава?
- 38. Почему возникает дифракция на кристаллической решетке?
- 39. Что такое дифрактометр?
- 40. Почему в стационарных дифрактометрах используют рентгеновское излучение?
- 41. Можно ли с помощью электронного микроскопа определить тип и параметры кристаллической решетки?

б) Вопросы, включенные в билеты для проведения зачетов

- 1. Основные положения теории вероятностей. Эксперимент как предмет исследования. Ошибки измерений и их оценка. Ошибки измерений: промахи, систематические, случайные.
- 2. Обработка результатов прямого измерения. Округление результатов. Выборочный метод.
- 3. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Функция распределения. Плотность распределения вероятностей. Законы распределения вероятностей: нормальный, показательный, равномерный.

- 4. Количественная металлография.
- 5. Задачи металлографического исследования и испытания материалов. Условия получения изображений в оптической микроскопии.
- 6. Способы обработки поверхности образца. Технология изготовления образцов. Изготовление специальных образцов.
- 7. Способы металлографического травления.
- 8. Приготовление объектов для ПЭМ.
- 9. Метод реплик и его применение.
- 10. Оптическая схема инвертированного микроскопа отраженного света.
- 11. Основные узлы микроскопа. Типы микроскопов.
- 12. Разрешающая способность, числовая апертура и глубина резкости микроскопа. Полезное увеличение.
- 13. Аберрации оптических систем. Типы объективов по степени исправления аберраций.
- 14. Методы контрастирования. Преимущества и недостатки использования оптической микроскопии в материаловедении.
- 15. Принцип работы просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). Формирование изображения в ПЭМ.
- 16. Основные типы контраста в ПЭМ. Основы кинематической теории дифракционного контраста. Принципы динамической теории. Контраст на кристаллах с дефектами. Анализ гетерогенного сплава. Контраст собственно на включениях.
- 17. Режим СТЭМ.
- 18. Принцип работы сканирующего (растрового) электронного микроскопа (РЭМ).
- 19. Основные типы сигналов, которые генерируются и детектируются в процессе работы РЭМ. Разрешающая способность.
- 20. Преимущества и недостатки использования электронной микроскопии в материаловедении.
- 21. Пробирный метод. Рентгенофлуоресцентный анализ. Эмиссионные методы.
- 22. Основные типы спектрометров для определения состава металлов: рентгенофлуоресцентный спектрометр, искровой оптико-эмиссионный спектрометр, лазерный спектрометр, масс-спектрометр. Преимущества и недостатки.
- 23. Взаимодействие электронного пучка с образцом. Рентгеноспектральный микроанализ в электронной микроскопии.
- 24. Основные методы определения фазового состава.
- 25. Качественный и количественный рентгенографический фазовый анализ.
- 26. Дифракция электронов в ПЭМ. Дифракция отраженных электронов в РЭМ.

Критерии оценки за освоение дисциплины определены в Инструктивном письме И-23 от 14 мая 2012 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

- 1. Материаловедение: учебник для втузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. 4-е изд., перераб. М.: Альянс, 2009. 528 с. (НТБ МЭИ 30 шт.)
- 2. Методы структурного анализа материалов и контроля качества деталей : учебное пособие для вузов / В. А. Батаев, А. А. Батаев, А. П. Алхимов. М.: Наука, 2007. 224 с. (НТБ МЭИ 3 шт.)
- 3. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия / Д. Синдо, Т. Оикава //М.: Техносфера, 2006. 256 с.(НТБ МЭИ 3 шт.)

Дополнительная литература:

4. Методы исследования структурно-фазового состояния материалов / Н. В. Волков, [и др.] // Нац. исслед. ядерный ун-т «МИФИ»; общ. ред. Б.А. Калин. -2012.-800 с. (НТБ МЭИ - 2 шт.)